



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H 2222A

对应国外型号
MPS2222A

主要用途

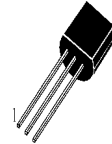
作音频功率放大，激励级放大、开关应用

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150
T_j ——结温	150
P_C ——集电极耗散功率	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压	75V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	40V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	6V
I_C ——集电极电流	600mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—基极, B
3—集电极, C

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	75			V	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	40			V	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			10	nA	$V_{CB}=60\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	nA	$V_{EB}=3\text{V}$, $I_C=0$
H_{FE}	直流电流增益	100		400		$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=150\text{mA}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.3	V	$I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$
f_T	特征频率	300			MHz	$V_{CE}=20\text{V}$, $I_C=20\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容			8	pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$